(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年10月2日(02.10.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/204951 A1

(51) 国際特許分類:
B24B 37/08 (2012.01) *B24B 57/02* (2006.01)
B24B 37/00 (2012.01) *G11B 5/84* (2006.01)
B24B 37/28 (2012.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/009486

(22) 国際出願日： 2025年3月12日(12.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-050265 2024年3月26日(26.03.2024) JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック・ハードディスク(**RESONAC HARD DISK CORP.**) [JP/JP]; 〒2900067 千葉県市原市八幡海岸通５番地１ (JP).

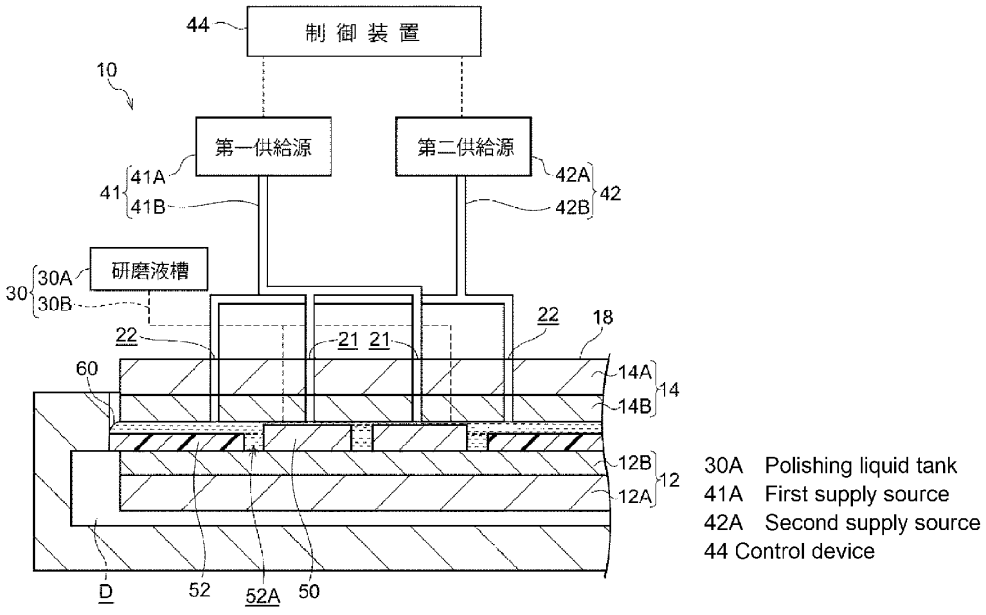
(72) 発明者: 久志野 高宏 (**KUSHINO, Takahiro**); 〒3238678 栃木県小山市犬塚１丁目４８０番地 株式会社レゾナック・ハードディスク内 (JP). 間舘 秀雄(**MADATE, Hideo**); 〒3238678 栃木県小山市犬塚１丁目４８０番地 株式会社レゾナック・ハードディスク内 (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人太陽国際特許事務所(**TAIYO, NAKAJIMA & KATO**); 〒1600022 東京都新宿区新宿４丁目３番１７号 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,

(54) **Title:** METHOD FOR MANUFACTURING DISK-SHAPED SUBSTRATE AND APPARATUS FOR MANUFACTURING DISK-SHAPED SUBSTRATE

(54) 発明の名称： 円盤状基板の製造方法及び円盤状基板の製造装置



(57) **Abstract:** This method for manufacturing a disk-shaped substrate comprises: a step for disposing, between a lower lapping plate and an upper lapping plate, a carrier that accommodates a disk-shaped substrate; a step for holding the disk-shaped substrate between the lower lapping plate and the upper lapping plate and polishing the disk-shaped substrate while supplying a processing liquid between the lower lapping plate and the upper lapping plate; a step for supplying, between the upper lapping plate and the disk-shaped substrate, a first detachment fluid for detaching the disk-shaped

WO 2025/204951 A1

［続葉有］

CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国（表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能）：ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）

substrate from the upper lapping plate by using a first supply system; and a step for supplying, between the upper lapping plate and the carrier, a second detachment fluid for detaching the carrier from the upper lapping plate by using a second supply system independent of the first supply system.

(57) 要約：円盤状基板の製造方法は、円盤状基板を収納するキャリアを下定盤と上定盤との間に配置する工程と、下定盤と上定盤とで円盤状基板を挟持して下定盤と上定盤との間に処理液を供給しつつ円盤状基板を研磨処理する工程と、上定盤と円盤状基板との間に、円盤状基板を上定盤から剥離する第一剥離流体を、第一供給系を用いて供給する工程と、上定盤とキャリアとの間に、キャリアを上定盤から剥離する第二剥離流体を、第一供給系から独立する第二供給系を用いて供給する工程と、を含む。